

日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

#2 3-24-11
JCS4U U.S. PTO
09/222524



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1997年12月26日

出願番号

Application Number:

平成 9年特許願第359478号

出願人

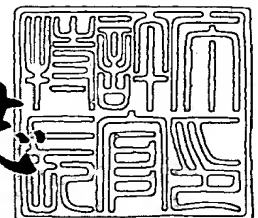
Applicant (s):

日本電気株式会社

1998年 7月31日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

伴佐山 建志



出証番号 出証特平10-3058790

【書類名】 特許願

【整理番号】 75310074

【提出日】 平成 9年12月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 21/60

【発明の名称】 半導体装置

【請求項の数】 6

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

 【氏名】 松田 修一

【特許出願人】

 【識別番号】 000004237

 【氏名又は名称】 日本電気株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100064621

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 山川 政樹

 【電話番号】 03-3580-0961

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 006194

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 9003065

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一方の面に所望のパタンの配線が形成された配線基板と、前記配線基板の他方の面に設置されるとともにチップ電極を有する半導体チップとを備え、前記配線と前記チップ電極とが、前記配線基板のスルーホール中に形成されたバンプを介して電氣的に接続された半導体装置において、

前記半導体チップは、この半導体チップ中の同一配線層に接続された2個以上のチップ電極を有し、

前記配線基板の一の配線は、前記2個以上のチップ電極のそれぞれに対向して設けられたバンプを介して、前記チップ電極と接続されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 一方の面に所望のパタンの配線が形成された配線基板と、前記配線基板の前記一方の面に設置されるとともにチップ電極を有する半導体チップとを備え、前記配線と前記チップ電極とが、バンプを介して電氣的に接続された半導体装置において、

前記半導体チップは、この半導体チップ中の同一配線層に接続された2個以上のチップ電極を有し、

前記配線基板の一の配線は、前記2個以上のチップ電極のそれぞれに対向して設けられたバンプを介して、前記チップ電極と接続されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項3】 請求項1または2において、

前記チップ電極は、前記半導体チップの縁から前記半導体チップの内側にかけて配列されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項4】 請求項1または2において、

前記チップ電極は、前記半導体チップの縁と平行に配列され、

前記配線は、少なくとも1箇所が折れ曲がっていることを特徴とする半導体装置。

【請求項5】 請求項1または2において、

前記チップ電極は、前記半導体チップの縁と平行に配列され、

前記配線は、その先端の幅が前記配列されたチップ電極の間隔以上であることを特徴とする半導体装置。

【請求項6】 請求項1または2において、

前記チップ電極は、前記半導体チップの接地端子、電源端子または信号端子の少なくとも何れか一つであることを特徴とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体装置に関し、特にチップ電極と配線基板上の配線との接続不良を防止する半導体装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来、チップサイズパッケージ（以下、CSP: Chip Size Packageという）と呼ばれ、パッケージの大きさを、半導体チップの大きさとほとんど同じくらいになるまで小さくしたものがある。

【0003】

ところで、このようなCSPには、半導体チップを搭載するためのインターポーザの種類に応じて複数の形態があり、その中の一つにフィルムキャリアを用いたものがある。

ところが、インターポーザにフィルムキャリアを用いた場合、フィルムキャリア上の配線と、半導体チップに設けられたチップ電極とを熱圧着によって接続すると、接続後に生じた応力によって接続部が離れて電氣的にオープンしてしまうことがあった。

【0004】

図7は、従来からある一般的なCSPの構成を示す斜視図である。

同図に示すように、半導体チップ1とTABテープ2とは、大きさがそれぞれほぼ等しく、半導体チップ1はフィルムキャリアであるTABテープ2の上に設置されている。

この半導体チップ1のA1製のチップ電極（図示せず）は、TABテープ2に開口されたスルーホール中のバンプ（図示せず）を介してバンプ9と電氣的に接続されている。そして、半導体チップ1の全体は、エポキシ等からなる封止樹脂8によって封止されている。

【0005】

図8は、図7のVIII-VIII'線における断面図を示す。

同図において、図7における同一または同等のものには、同一符号を付しており、TABテープ2はベースとなるポリイミドテープ2bと、その上に形成された銅箔からなる配線2aとから構成されており、半導体チップ1を搭載するためのフィルムキャリア（配線基板）として機能する。

【0006】

配線2aは、ポリイミドテープ2b上に予め形成された所望の配線パターンであり、バンプ6はポリイミドテープ2bに開口されたスルーホール中に銅を蒸着することによって形成されている。そして、バンプ6の露出した表面には、NiまたはAu等からなるバンプ5がメッキによってさらに形成されている。

一方、チップ電極4は半導体チップ1中の配線層3に電氣的に接続されており、半導体チップ1の表面は、このチップ電極4が露出するようにしてチップカバー膜12によって覆われている。

【0007】

以上のようにして作られたフィルムキャリアは、半導体パッケージの組立において次のようにして用いられる。

まず、バンプ5とチップ電極4とが対向するようにして位置合わせをしてから、バンプ6直上の配線2aをボンディングツールにより、超音波振動や熱を加えながら押圧する。すると、バンプ5は変形して接触面でAu・Al合金が形成され、チップ電極4とバンプ5とは熱圧着される。また、半導体チップ1とチップカバー膜12とは接着材11によって接着され、以上の結果、半導体パッケージができあがる。なお、露出している配線2a等の表面にはソルダーレジスト10が塗布され、腐食等から保護されている。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来においては bumps 5 とチップ電極 4 との熱圧着して接続した後に、TAB テープ 2 等の応力によってその接続部が離れてしまい、組立後の検査においてオープン不良が発見されるという問題点があった。

本発明は、このような課題を解決するためのものであり、チップ電極と bumps との接続不良を防止した半導体装置を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】

このような目的を達成するために、請求項 1 に係る本発明の半導体装置は、一方の面に所望のパタンの配線が形成された配線基板と、上記配線基板の他方の面に設置されるとともにチップ電極を有する半導体チップとを備え、上記配線と上記チップ電極とが、上記配線基板のスルーホール中に形成された bumps を介して電氣的に接続された半導体装置において、上記半導体チップは、この半導体チップ中の同一配線層に接続された 2 個以上のチップ電極を有し、上記配線基板の一の配線は、上記 2 個以上のチップ電極のそれぞれに対向して設けられた bumps を介して、上記チップ電極と接続されたものである。

また、請求項 2 に係る本発明の半導体装置は、一方の面に所望のパタンの配線が形成された配線基板と、上記配線基板の上記一方の面に設置されるとともにチップ電極を有する半導体チップとを備え、上記配線と上記チップ電極とが、bumps を介して電氣的に接続された半導体装置において、上記半導体チップは、この半導体チップ中の同一配線層に接続された 2 個以上のチップ電極を有し、上記配線基板の一の配線は、上記 2 個以上のチップ電極のそれぞれに対向して設けられた bumps を介して、上記チップ電極と接続されたものである。

また、請求項 3 に係る本発明の半導体装置は、請求項 1 または 2 において、上記チップ電極は、上記半導体チップの縁から上記半導体チップの内側にかけて配列されていることを特徴とする半導体装置。

また、請求項 4 に係る本発明の半導体装置は、請求項 1 または 2 において、上記チップ電極は、上記半導体チップの縁と平行に配列され、上記配線は、少なくとも 1 箇所が折れ曲がったものである。

また、請求項5に係る本発明の半導体装置は、請求項1または2において、上記チップ電極は、上記半導体チップの縁と平行に配列され、上記配線は、その先端の幅が上記配列されたチップ電極の間隔以上である。

また、請求項6に係る本発明の半導体装置は、請求項1または2において、上記チップ電極は、上記半導体チップの接地端子、電源端子または信号端子の少なくとも何れか一つである。

このように構成することにより本発明は、同一配線層に対して少なくとも2組のチップ端子およびバンプを備えているため、仮に1箇所の接続が離れてしまってもその他の箇所で接続されており、オープン不良を生じにくいという効果を有する。

【0010】

【発明の実施の形態】

次に、本発明の一つの実施の形態について図を用いて説明する。

図1は、本発明の一つの実施の形態を示す平面図である。

同図において、図8における同一または同等の部品には同一符号を付しており、半導体チップ1の同一配線層3には2個のチップ電極4（例えば、A1で作られている）が接続されている。

一方、これらのチップ電極4は、何れともTABテープ2上の同一配線2aに接続され、また配線2aの末端にはバンプを取り付けるためのパッド2cが形成されている。なお、配線2aは銅で形成された所望パタンの配線である。

【0011】

ここで、図1に係る半導体装置の製造工程について説明する。

図2は、図1のII-II'線における断面図であり、図1に係る半導体装置の製造工程を示す。

同図において、図1における同一または同等の部品には同一符号を付しており、図2(a)，(b)はそれぞれ製造工程の各段階を示している。

【0012】

まず、図2(a)において、フィルムキャリアであるTABテープ2は、ベースとなるポリイミドテープ2bと、その上に形成された銅箔からなる配線2aと

から構成されている。そして、パンプ5とチップ電極4とを位置合わせしてからパンプ6直上の配線2aを2個のボンディングツール7によって超音波振動や熱を加えながら押圧して、半導体チップ1をTABテープ2上に搭載する。

【0013】

すると、図2(b)に示すように、加わった圧力によってパンプ5が変形し、接触面ではAu・Al合金が形成され、2組のパンプ5とチップ電極4とは互いに熱圧着される。

なお、より強い接合強度を望むので有れば、3箇所以上にパンプ5、6およびそれらに対応するチップ電極4を設けてもよいことは明らかである。

【0014】

図3は、図1に係る構造を用いた半導体パッケージを示す断面図である。

同図において、図1における同一または同等の部品には同一符号を付しており、配線2aはパンプ5、6を介して、2箇所でチップ電極4と接続されている。そして、配線2aの末端にはパッド2cが形成され、このパッド2cには実装基板と接続するためのパンプ9が設けられている。

【0015】

次に、本発明のその他の実施の形態について説明する。

図4、5は、本発明のその他の実施の形態を示す平面図である。

同図において、図3における同一または同等の部品には同一符号を付しており、これらの実施の形態においては、同一配線層3に接続された2個のチップ電極4が半導体チップ1の縁に対して平行に配列されている点に特徴がある。

【0016】

このような場合、図1に記載したような直線状の配線2aの代わりに、先端の一部を折り曲げた（ここでは90°）配線2a（図4）を用いたり、先端の幅をチップ電極4の間隔よりも広くした配線2a（図5）を用いたりして、2個のチップ電極4に配線2aを接合する。もちろん、配線2aとチップ電極4とは、パンプを介して接続される。

【0017】

なお、本発明は半導体チップ1に設けられているあらゆる端子、すなわち電源

端子（VCC）、接地端子（GND）、信号端子に適用できることは明らかである。特に、接地端子に関して述べると以下のような効果が得られることがわかる。

【0018】

すなわち、通常、電源端子および接地端子は複数設けられており、1箇所程度オープン不良を起こしても実際の機能として支障をきたすことはない。しかし、ユーザによる製品の受け入れ検査においては、1箇所でもオープン不良が生じると、技術力等に対する信用問題が生じることがある。そこで、上記に記載したような本発明を少なくとも電源端子や接地端子のみについてだけでも適用しておけば、このような事態を回避することができる。もちろん、チップ電極の占有面積が大きくなってしまうという若干のデメリットはあるが、電源端子や接地端子にのみ用いるのであればそれほど問題とはならないし、また確実な接続が得られるので占有面積を多少犠牲にしても適用する価値はある。

【0019】

また、上記実施の形態においては、半導体チップ1の裏面に搭載した例について述べたが、配線2aとバンプ5とを向かい合わせるようにしたものにおいても、本発明を適用できることは明らかであり、例えば図6に示されるような構成となる。

【0020】

【発明の効果】

以上説明したように本発明は、配線基板上の配線と、半導体チップの同一配線層に接続された2個以上のチップ電極とを接続するようにしたので、仮に1箇所の接続が離れてしまってもその他の箇所で接続されているため、オープン不良を生じにくいという効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一つの実施の形態を示す平面図である。

【図2】 図1に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。

【図3】 図1の構成を採用したパッケージを示す部分断面図である。

【図4】 本発明のその他の実施の形態を示す平面図である。

【図5】 本発明のその他の実施の形態を示す平面図である。

【図6】 本発明のその他の実施の形態を示す部分断面図である。

【図7】 一般的なCSPの構成を示す斜視図である。

【図8】 図7のVIII-VIII'線における部分断面図。

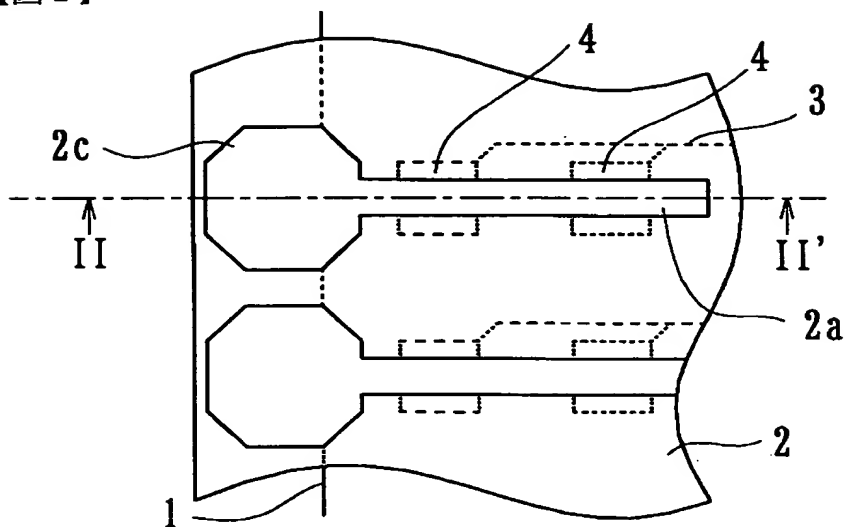
【符号の説明】

1…半導体チップ、2…TABテープ、2a…配線、2bポリイミドテープ、
、2c…パッド、3…配線層、4…チップ電極、5，6，9…バンプ、7…ボン
ディングツール、8…封止樹脂、10…ソルダーレジスト、11…接着材、12
…チップカバー膜。

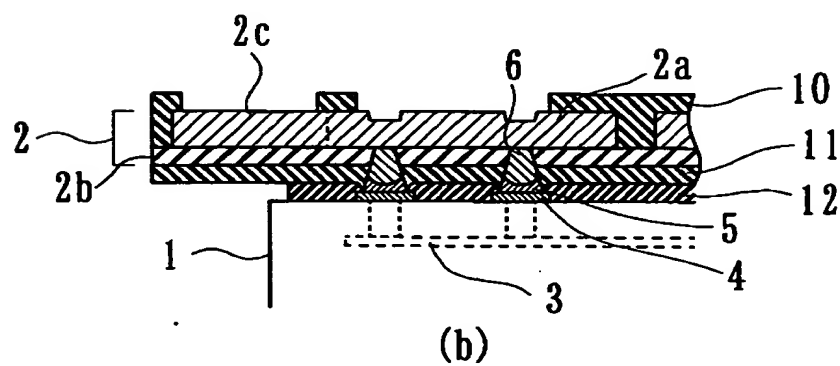
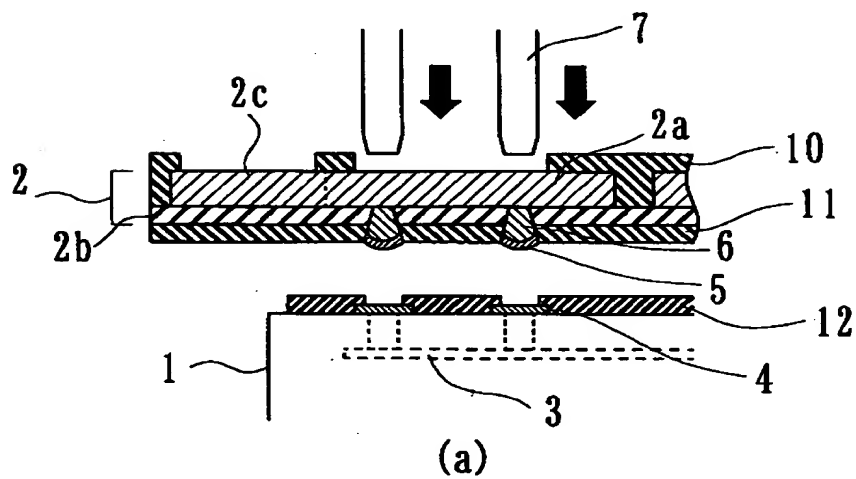
【書類名】

図面

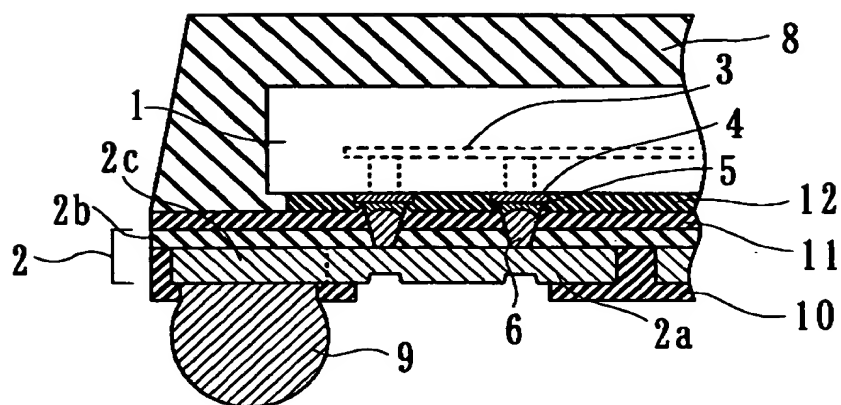
【図1】



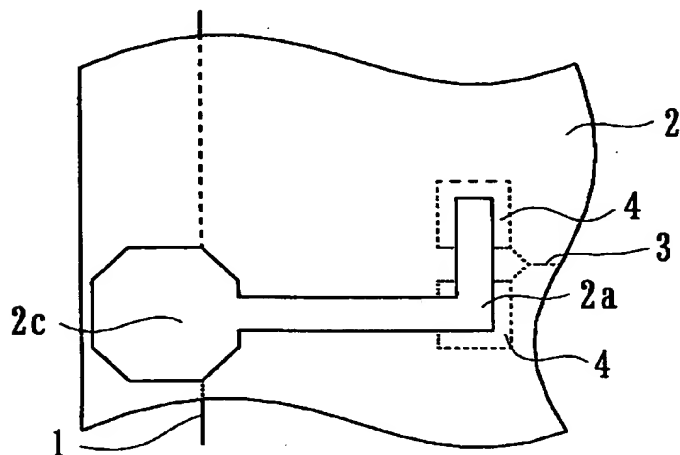
【図2】



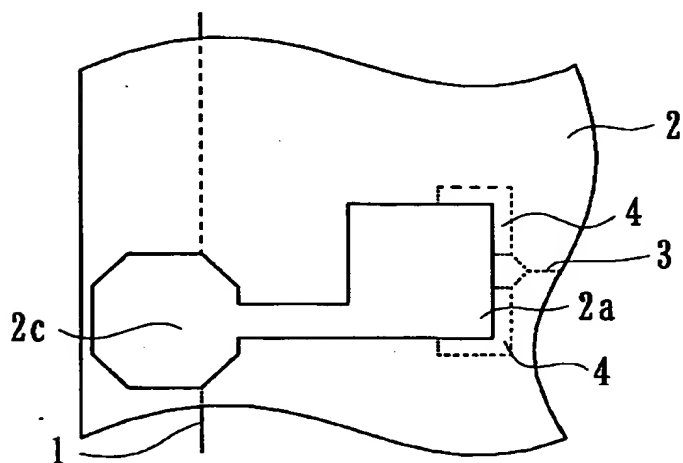
【図3】



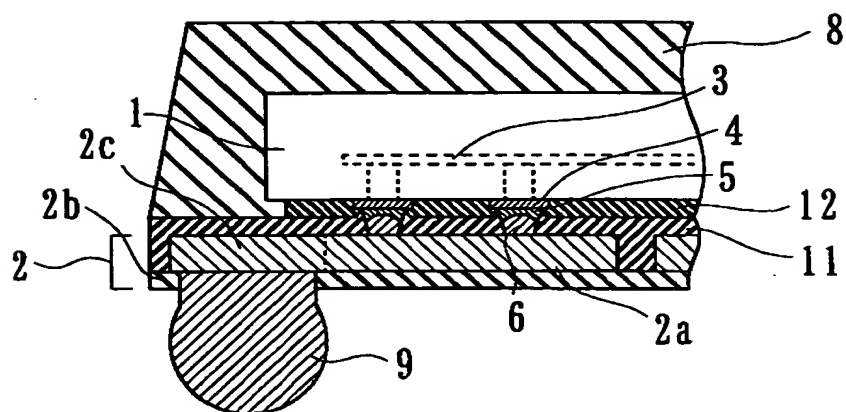
【図4】



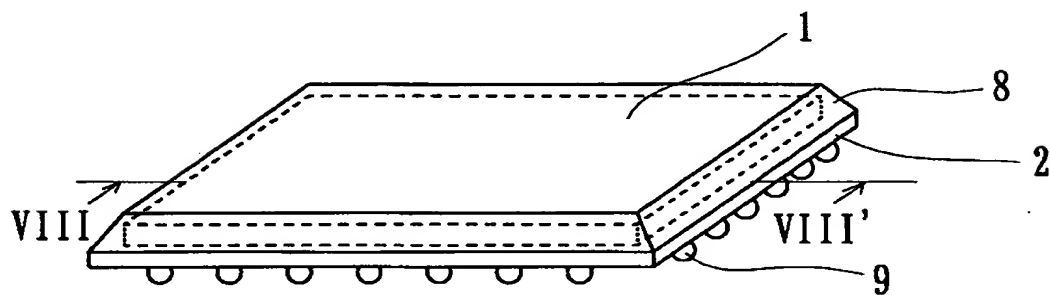
【図5】



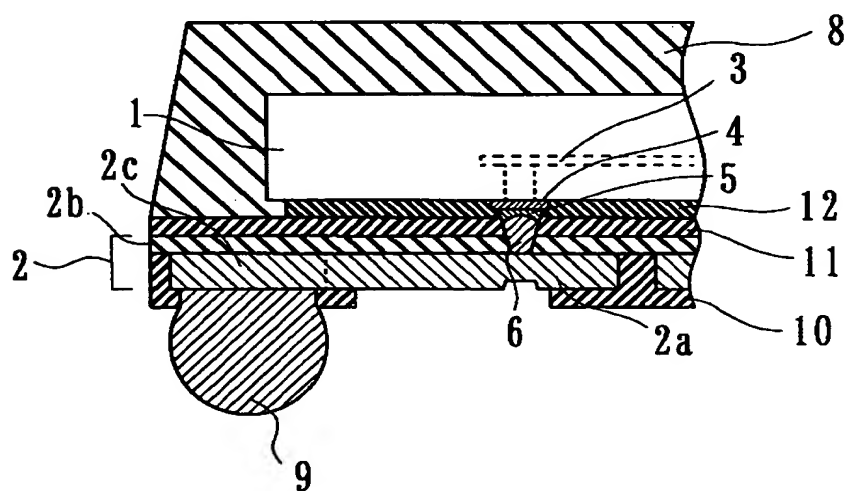
【図6】



【図7】



【図8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 チップ電極とバンプとの接続不良を防止する。

【解決手段】 一方の面に所望のパタンの配線 2 a が形成された T A B テープ 2 と、その他方の面に設置されるとともにチップ電極 4 を有する半導体チップ 1 とを備え、配線 2 a とチップ電極 4 とが、スルーホール中に形成されたバンプ 5, 6 を介して電氣的に接続されている。そして、半導体チップ 1 は、配線層 3 に接続された 2 個以上のチップ電極 4 を有し、配線 3 は、2 個以上のチップ電極 4 のそれぞれに対向して設けられたバンプ 5, 6 を介して、チップ電極 4 と接続されている。

【選択図】 図 3

【書類名】
【訂正書類】

職権訂正データ
特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000004237

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号

【氏名又は名称】

日本電気株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100064621

【住所又は居所】

東京都千代田区永田町2丁目4番2号 秀和溜池ビル8階山川国際特許事務所内

【氏名又は名称】

山川 政樹

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000004237]

1. 変更年月日	1990年 8月29日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都港区芝五丁目7番1号
氏 名	日本電気株式会社